DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2004 EPO. All rts. reserv.

12328032

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 7092467 A2 950407 <No. of Patents: 001> PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT (English)

Patent Assignee: TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Author (Inventor): YAMAMOTO TAKAHIRO; OKAMOTO MASUMI; YAMAMOTO

TAKESHI; HADO HITOSHI

IPC: *G02F-001/1337;

CA Abstract No: 123(02)022401S Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 7092467 A2 950407 JP 93241054 A 930928 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 93241054 A 930928

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 04799867

PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

PUB. NO.:

07-092467 [JP 7092467 A]

PUBLISHED:

April 07, 1995 (19950407)

INVENTOR(s): YAMAMOTO TAKAHIRO

OKAMOTO MASUMI

YAMAMOTO TAKESHI

HADO HITOSHI

APPLICANT(s): TOSHIBA CORP [000307] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

05-241054 [JP 93241054]

FILED:

September 28, 1993 (19930928)

INTL CLASS:

[6] G02F-001/1337

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R105 (INFORMATION PROCESSING --

Ink Jet Printers); R119 (CHEMISTRY -- Heat Resistant Resins)

ABSTRACT

PURPOSE: To improve a visual characteristic selectively depositing different oriented film materials formed in a drop form by each of the desired positions a substrate by using an ink jet device, etc.

CONSTITUTION: A counter substrate 3 formed with a common counter electrode 1 on a glass substrate 2 and a TFT substrate 6 formed with pixel electrodes 4 consisting of ITO and TFT elements on a glass substrate 5 are prepared The pixel electrodes 4 are connected to the TFT elements and a polyimide is applied and formed as the liquid crystal oriented film 7 by a printing method on the counter substrate 3. The polyimide is applied and formed in a stripe form as the first liquid crystal oriented film 8 by using a scannable ink jet device on the TFT substrate 6 in such a manner that the pixel regions formed by the respective pixel electrodes 4 are respectively bisected; thereafter, the polyimide varying in pretilt angle is applied similarly in the stripe form as the second liquid crystal oriented film 9

in the remaining regions where the first liquid crystal oriented film 8 is

not formed.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-92467

(43)公開日 平成7年(1995)4月7日

(51) Int. C1. 6

識別記号

G02F 1/1337

505

FΙ

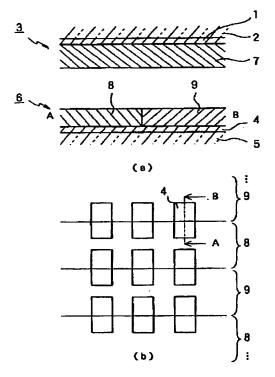
審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全7頁)

(21)出願番号	特願平5-241054	(71)出願人 000003078
		株式会社東芝
(22)出願日	平成5年(1993)9月28日	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
		(72)発明者 山本 恭弘
		神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株
		式会社東芝横浜事業所内
		(72)発明者 岡本 ますみ
		神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株
		式会社東芝横浜事業所内
		(72)発明者 山本 武志
		神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株
		式会社東芝横浜事業所内
		(74)代理人 弁理士 須山 佐一
		最終百に続く

(54) 【発明の名称】液晶表示素子の製造方法

(57)【要約】

【目的】 視角特性の良好な液晶表示素子を実現する。 【構成】 インクジェット装置等を用いて、滴状にした 異なる配向膜材料8、9を、基板上の所望の位置ごとに 選択的に被着させているので、その2種類の配向膜材料 8、9の被着位置を極めて簡易かつ正確に制御すること ができる。その結果、異なる複数の液晶配向膜8、9を 選択的に正確に形成することができる。



20

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に電極をそれぞれ有する第1の基板および第2の基板それぞれの上に、前記電極を覆うように液晶配向膜を形成する工程と、前記第1の基板および第2の基板を前記電極どうしが対向して画素を形成するように間隙を有して対向配置し、基板の周囲を封止して該間隙に液晶組成物を注入して挟持させる工程とを有する液晶表示素子の製造方法において、

前記第1の基板および第2の基板の少なくとも一方の基板に対して、異なる複数の種類の液晶配向膜材料をそれ 10 ぞれ細孔から滴状に出射させて前記基板上へ選択的に被着させ、液晶配向状態の異なる複数の領域を有する液晶配向膜を形成する工程を具備することを特徴とする液晶表示素子の製造方法。

【請求項2】 請求項1記載の液晶表示素子の製造方法において、

前記液晶配向膜材料をインクジェット装置を用いて出射 することを特徴とする液晶表示素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は液晶表示素子の製造方法 に係り、特に複数の異なる液晶配向領域を有して視角特 性を改善した液晶表示素子の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、薄型・軽量・低消費電力といった 特長を有する液晶表示素子は、日本語ワードプロセッサ やデスクトップパーソナルコンピュータ等の〇A機器の 表示素子として盛んに用いられている。このような液晶 表示素子の中でも、ネマティック液晶と呼ばれる、液晶 分子の捩じれ配列による光変調特性を用いた液晶表示素 30 子が一般的に実用に供せられている。その表示方式とし ては、旋光モードと複屈折モードとの 2つの方式に大別 することができる。

【0003】旋光モードのLCDは、例えば90°捩れ分 子配列のツイステッドネマティック(TN)型液晶表示 素子が従来から一般的に用いられており、これは原理的 には白黒表示で高コントラスト比が得られることから、 時計や電卓などに主に用いられてきた。このTN型液晶 表示素子は、良好な階調表示性能を有し、応答速度が一 般に数10m s 程度と比較的速いことから、走査電極と信 号電極が交差してマトリックス上に画素を形成するよう な単純マトリックス型駆動方式をはじめとして、MIM 素子あるいはTFT素子などを用いたアクティブマトリ ックス駆動方式の液晶表示素子に用いられ、さらにカラ ーフィルタと組み合わせてフルカラー表示を行なう液晶 テレビやOA機器用ディスプレイデバイスなどに応用さ れている。一方複屈折モードの表示方式の液晶表示素子 は、基板間(セルギャップ)で液晶分子が90°以上捩れ た分子配列を有するスーパーツイステッドネマティック (STN)型液晶を用いたもので、急俊な電気光学特性 50 を有していることから単純マトリックス型の液晶表示素 子においても時分割駆動によって良好なコントラスト特 性や階調再現性を実現することができる。

【0004】しかしながら、このような従来の液晶表示 素子においては、画面に対する観測者の視角や左右ある いは上下方向ごとにコントラスト特性や表示色が大きく 変化するという視角依存性を有している。そこでこのよ うな液晶表示素子の視角依存性を改善るために従来種々 の技術が提案されている。その中の一つとして、近年提 案された、K.H.YANG (1991 I D R C 、 p68) の提案した 技術で、一画素内に液晶分子の起き上がる方向が180° 異なる 2つの領域を設けた液晶表示素子を用いて視角依 存性を改善するというTwo Domain TN (T DTNと称する)方式が知られている。またこのような TDTNをさらに進めて、一画素内にプレチルトの異な る領域を、同一基板内で同一方向のラビング配向処理に よって設けるというドメイン分割TN (Y. Koike, et. al 1992S I D、p798 ; このような技術をDDTNと称す る)が知られている。

【0005】これらの技術は、同一基板上の同一配向膜面内で液晶分子の配向状態を変えた異なる領域を形成するために、基板上に配向膜材料層を成膜し、その一部分を選択的にマスクで被覆して、マスクから露出した部分の配向膜材料層の上にだけ選択的にラピング処理を行なうというものである。またDDTNの場合は無機化合物を材料とする配向膜を形成した後、その無機化合物配向膜上に有機化合物の配向膜を形成し、これにフォトリソグラフィ法を用いて有機化合物配向膜を例えば一画素の半分だけ残し、その上に一度のラビング処理を行なうことで、有機化合物配向膜上と無機化合物配向膜上とでプレチルト角の異なった複数の領域を形成し、液晶分子の配向状態を180°変えるというものである。

【0006】図4(a)はTDTN方式の液晶表示素子を形成する工程を示す図である。これはマスク401から露出している配向膜材料層403の一部分に対して選択的に一度のラピング処理によってラピング配向を施すもので、例えば液晶分子の配列が1画素内で180°異なった2領域を形成するものである。あるいはマスク401から露出した配向膜材料層403の一部分の上に選択的にSiO,等のマスク材料を成膜しこれをマスク401として用いて、液晶分子配向の異なる2領域を一画素内で形成する。

【0007】具体的には、マスクラビング法の場合、まずガラス基板405上の配向膜材料層403ほぼ全面に第1回目のラビング処理を行なう。次に、その上をフォトリソグラフィで1画素の半分だけ被覆するようにパターニングしてレジスト膜を形成しマスク401とし、そのマスク401から露出した部分の配向膜材料層403に第1回目のラビング方向とは180°逆方向のラビング処理を行なう。そして配向膜材料層403上を被覆して

いたレジスト膜からなるマスク401を剥離して、上記のような180°配向方向の異なる2領域をそれぞれの画素電極407上に形成する。あるいは隣り合う画素電極407ごとに配向方向が異なるように形成する。

【0008】SiO_xのマスク蒸着法は、メタルマスク等を用いて異なるSiO_xの蒸着を異なる領域ごとに2回以上に分けて行なう方法である。

【0009】しかしながら、上記の方法では、まずマスクラビングの場合はレジスト被覆により第1回目のラビング処理の効果が大幅に低減してしまうという問題があ 10る。一方マスク蒸着法の場合では、そのマスクを精度よく一画素ごとにアライメントすることが、画素のさらなる微細化、多画素化が進む液晶表示素子にあってはますます困難であるという問題がある。

【0010】図4(b)は前記のY.Koikeらの提案した方法を示す図である。この手法は無機化合物配向膜501を第一層目に形成し、第二層目には有機化合物配向膜503を設けるというものである。このような有機化合物配向膜503と無機化合物配向膜501とを選択的に一つの基板405上に設けることによって、一つの基板20405上に異なる配向状態の2領域を設けることができるはずである。

【0011】しかしながら、本発明者らの実験によれば、無機化合物配向膜501上では長期間にわたる液晶表示素子の使用によって表面の配向能力が低下するという問題、および比較的膜質の硬い無機化合物配向膜501と柔らかい有機化合物配向膜503とに一度のラビング処理で配向制御を施すために、これらの異なる膜質の領域で液晶配向能に著しい差が生じてしまう。その結果、これらの領域間で配向能の対称性が著しく損なわれ30てしまい、むしろ視角特性が大幅に低下するという問題があることが確認された。

【0012】また、印刷法を用いて、図5に示すように 2種類の有機配向膜601、603を互いに隣り合うようにストライプ状に形成するという手法も案出される が、本発明者らの実験によれば、実効的な 330 μ mピッチ程度のストライプの正確な形成は困難であるという問題があることが確認された。

【0013】また、脱水閉環系ポリイミドおよび可溶性ポリイミドを膜材料として用いて、これをフォトリソグ 40ラフィ法でストライプ状に形成して前記の図5に示すような2種類の有機配向膜601、603を形成するという手法も案出されるが、本発明者らの実験によれば、実効的な330μmピッチ程度のストライプの正確な形成が困難であるという問題があることが確認された。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような問題を解決するために成されたもので、その目的は、配向状態の異なる複数の領域を簡易な手法によって形成することができ、さらに液晶分子の配向能の制御の自由度が 50

高く、かつ得られた配向膜の信頼性および耐久性の高い 液晶表示素子の製造方法を提供することにある。そして その結果、視角特性の良好な液晶表示素子を実現するこ とにある。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示素子の 製造方法は、基板上に電極をそれぞれ有する第1の基板 および第2の基板それぞれの上に、前記電極を覆うよう に液晶配向膜を形成する工程と、前記第1の基板および 第2の基板を前記電極どうしが対向して画素を形成する ように間隙を有して対向配置し、基板の周囲を封止して 該間隙に液晶組成物を注入して挟持させる工程とを有す る液晶表示素子の製造方法において、前記第1の基板 よび第2の基板の少なくとも一方の基板に対して、異な る複数の種類の液晶配向膜材料をそれぞれ細孔から滴状 に出射させて前記基板上へ選択的に被着させ、液晶配向 状態の異なる複数の領域を有する液晶配向膜を形成する 工程を具備することを特徴としている。

【0016】あるいは、上記の液晶配向膜材料をインクジェット装置から出射することを特徴としている。

【0017】なお、上記のインクジェット装置等から出射される滴状態の配向膜材料の材質や、出射速度、滴の径、滴の粘性率等の、本発明の目的を達成するための好適値としては、製造する液晶表示素子の画素のサイズや、形成したい配向膜の配向能などの諸条件によって異なるものの、インクジェット装置等により出射されて基板上に被着されたときに飛散や拡散がなく、その配向膜材料の滴の被着位置が正確に制御できるようにあらかじめ設定しておくことが望ましいことは言うまでもない。

[0018]

【作用】インクジェット装置等を用いて、滴状にした異なる配向膜材料を、基板上の所望の位置ごとに選択的に被着させているので、その2種類の配向膜材料の被着位置を極めて簡易かつ正確に制御することができる。その結果、異なる複数の液晶配向膜を選択的に正確に形成することができる。

[0019]

【実施例】以下、本発明に係る液晶表示素子の製造方法 の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。

【0020】(実施例1)図1(a)は、本発明に係る 製造方法により製造される液晶表示素子の構造を示す断 面図、図1(b)はその平面図である。

【0021】 ITO (酸化インジウム錫) の透明電極からなる共通対向電極1がガラス基板2の上に形成された対向基板3と、ITOからなる画素電極4およびTFT素子(図示省略)がガラス基板5上に形成されたTFT基板6とを用意する。画素電極4は前記のTFT素子に接続されており、この画素電極4は画素サイズ 110×32 0 μ mのITO透明電極から形成された電極である。

【0022】対向基板3上には、液晶配向膜7としてプ

レチルト角が4°のポリイミド(日本合成ゴム社製)を 印刷法で85nmの厚さに均一に塗布して形成した。

【0023】TFT基板6上には、第1の液晶配向膜8としてプレチルト角が1°のポリイミド(日本合成ゴム社製)を走査可能なインクジェット装置を用いて各画素電極4により形成される画素領域をそれぞれ2分するようにストライプ状に330μm幅で塗布し形成した後に、さらに第2の液晶配向膜9としてプレチルト角が7°のポリイミド(日本合成ゴム社製)をストライプ状に前記の第1の液晶配向膜8を形成していない残りの領域に同10様にストライプ状に330μm幅で塗布した。このように、液晶配向特性の異なる2つの種類の第1の液晶配向膜8および第2の液晶配向膜9を正確に交互にストライプ状に配置することにより、一画素あたりを2分して、これら2つの領域ごとで異なる配向能を実現することができた。

【0024】そして対向基板3およびTFT基板6上のそれぞれの配向膜7、8、9にセルギャップ間で液晶分子が90° 捩れてスプレイ配列されるように一度のラビング配向処理を行なって、互いの配向膜が形成された面が20対向するように、周囲を封止材(図示省略)で封止して間隙を有して対向配置して組み合わせ、その基板間隙

(セルギャップ) に液晶組成物 (ZLI-1132、E. Merck 社製) を注入して液晶層として挟持させて、本発明に係る液晶表示素子を作製した。

【0025】このような第1の実施例の液晶表示素子を 駆動してテストパターンを表示させ、その表示品位を目 視にて検証したところ、視野角特性が画面の上下、およ び左右方向で均一でコントラスト比の高い良好な画像表 示が実現できることが確認された。このときの画面の等 30 コントラスト曲線を図3に示す。

【0026】(実施例2)上記の第1の実施例において、TFT基板6上に形成する配向膜8、9の形成位置を下記のように変更した。

【0027】すなわち、図2に示すように、画素電極4で形成される隣り合う一画素領域ごとに交互に第1の液晶配向膜8と第2の液晶配向膜9とをストライプ状に配列するように、上記と同様のインクジェット装置を用いて形成した。そしてその他の構造は第1の実施例とほぼ同様のものとなるように製造した。このような第2の実 40施例の液晶表示素子を駆動してテストパターンを表示させ、その表示品位を目視にて検証したところ、視野角特性が良好でコントラスト比の高い良好な画像表示を実現できることが確認された。

【0028】上記の第1の液晶配向膜8の材料として用いたポリイミドとしては比較的プレチルト角の高いSE-7211(日産化学製)を用いた。また第2の液晶配向膜9の材料としては比較的低いプレチルト角を有するポリイミドとしてSE-7310(日産化学製)を用いた。またこれらのポリイミドは、インクジェット装置から出射するイ

ンクとして用いたとき、その粘度は水の粘性率とほぼ同 程度であった。

【0029】そしてこのとき用いたインクジェット装置としては、ポリイミドの塗布状態が半画素ピッチの1.65 μm、膜厚が概ね8μmとなるように、ノズル径および出射速度を調整した。この調整は、形成すべきポリイミド膜の膜厚や塗布ピッチに対応して適宜に変更することが望ましいことは言うまでもない。また滴を出射する際の位置決めの方法としては、例えばアクチュエータでノズルを基板上で移動して行なってもよく、あるいはノズルを固定してX-Yステージに基板を固定し、X-YステージをX方向およびY方向に移動させてもよい。そのような方法でノズルと基板との相対的な位置関係を正確に制御することができればよい。

【0030】なお、上記の第1の液晶配向膜8および第2の液晶配向膜9のプレチルト角については、上記実施例の角度の他にも種々変更が可能である。

【0031】また、上記の実施例ではインクジェット装置を 2機用いて、1機ごとに異なる配向膜材料を出射させたが、この他にも、1機のインクジェット装置を使い分けて 2種類の配向膜材料を順次に出射して上記と同様の配向膜を形成することも可能である。

【0032】また、上記のインクジェット装置のノズルから配向膜材料をインクとして滴状に出射する際に、ノズルからの出射直後に配向膜材料の滴の飛散が生じる場合には、そのような飛散を遮蔽するために、不要な方向へと飛散する滴を遮蔽するとともに必要な方向(つまり基板上の所望の位置)へと向かう滴は通過させるようにフィルタ孔が穿設された飛散遮蔽マスク(スクリーン)を、インクジェット装置のノズルの出射孔の前面に配置すればよい。

【0033】また、上記実施例はTFTを用いたいわゆるアクティブマトリックス型の液晶表示素子に本発明の技術を適用した場合について説明したが、本発明はこれのみには限定しない。この他にもMIMを用いたアクティブマトリックス型液晶表示素子においても、好適に用いることができる。

【0034】また、液晶組成物としては、TNあるいはSTN以外にも、GH(GUEST-HOST)モードの液晶表示素子に対しても好適に用いることができる。【0035】その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、本発明に係る液晶表示素子の製造の際に用いる材料等の変更が種々可能であることは言うまでもない。

[0036]

【発明の効果】以上、詳細な説明で明示したように、本 発明によれば、配向状態の異なる複数の領域を簡易な手 法によって形成することができ、さらに液晶分子の配向 能の制御の自由度が高く、かつ得られた配向膜の信頼性 および耐久性の高い液晶表示素子の製造方法を提供する

Q

ことができる。そしてそのような製造方法によって、視 角特性の良好な液晶表示素子を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施例の製造方法によって製造される液晶表示素子を示す図である。

【図2】第2の実施例の製造方法によって製造される液晶表示素子を示す図である。

【図3】第1の実施例の製造方法によって製造された液晶表示素子の表示画面の等コントラスト曲線を示す図である。

【図4】従来のTDTN方式およびDDTN方式の液晶表示素子のマスク法による製造方法を示す図である。

【図5】従来のTDTN方式およびDDTN方式の液晶 表示素子の印刷法による製造方法を示す図である。

【符号の説明】

1…共通対向電極、2…ガラス基板、3…対向基板、4 …画素電極、5…ガラス基板、6…TFT基板、7…対 向基板側の液晶配向膜、8…第1の液晶配向膜、9…第 2の液晶配向膜

10

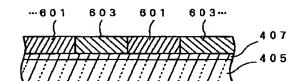
[EXI]

[EXII]

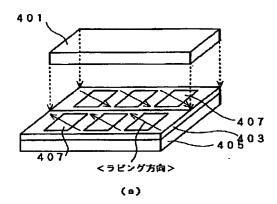
[EXIII]

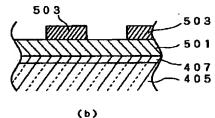
[EXI

【図5】



【図4】





【手続補正書】

【提出日】平成5年12月3日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正内容】

【0013】また、脱水閉環系ポリイミドおよび可溶性ポリイミドを膜材料として用いて、これをフォトリソグラフィ法でストライプ状に形成して前記の図5に示すような2種類の有機配向膜601、603を形成するという手法も案出されるが、本発明者らの実験によれば、実効的な330μmピッチ程度のストライプの正確な形成が困難であるという問題があることが確認された。また、フォトリソグラフィ法でポリイミドのストライプパターンを形成する場合、使用するフォトレジストや現像液や剥離液等により配向膜がダメージを受けて信頼性が著しく低下するという問題があった。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0027

【補正方法】変更

【補正内容】

【0027】すなわち、図2に示すように、画素電極4 の半画素領域ごとに交互に第1の液晶配向膜8と第2の 液晶配向膜9とをストライプ状に配列するように、上記 と同様のインクジェット装置を用いて形成した。そして その他の構造は第1の実施例とほぼ同様のものとなるように製造した。このような第2の実施例の液晶表示素子を駆動してテストパターンを表示させ、その表示品位を目視にて検証したところ、視野角特性が良好でコントラスト比の高い良好な画像表示を実現できることが確認された。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0029

【補正方法】変更

【補正内容】

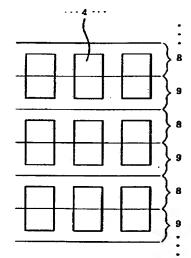
【0029】そしてこのとき用いたインクジェット装置としては、ポリイミドの塗布状態が半画素ピッチの1.65μm、膜厚が概ね85nmとなるように、ノズル径および出射速度を調整した。この調整は、形成すべきポリイミド膜の膜厚や塗布ピッチに対応して適宜に変更することが望ましいことは言うまでもない。また滴を出射する際の位置決めの方法としては、例えばアクチュエータでノズルを基板上で移動して行なってもよく、あるいはノズルを固定してX-Yステージに基板を固定し、X-YステージをX方向およびY方向に移動させてもよい。そのような方法でノズルと基板との相対的な位置関係を正確に制御することができればよい。

【手続補正4】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図2

【補正方法】変更 【補正内容】 【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 羽藤 仁

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝横浜事業所内